PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

11-282155

(43) Date of publication of application: 15.10.1999

(51)Int.CI.

G03F 7/027 CO8F 2/44 C08F283/04 C08L 51/08 CO8L 79/08 G03F 7/004 GO3F 7/30 H05K 3/28

(21)Application number: 10-081841

(22)Date of filing:

27.03.1998

(71)Applicant:

(72)Inventor:

HITACHI CHEM CO LTD

KAWAKAMI HIROYUKI

TSUCHIKAWA SHINJI **OTA FUMIHIKO NISHIZAWA HIROSHI AIZAWA TERUKI NUMATA SHUNICHI**

(54) PHOTOSENSITIVE RESIN COMPOSITION AND PRODUCTION OF SOLDER RESIST USING THAT

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive resin compsn. excellent in heat resistance, adhesion property and moisture resistance (PCT resistance) and to provide a producing method of a substrate having a solder resist excellent in workability and photosensitive characteristics.

SOLUTION: This photosensitive resin compsn. contains (A) a polyimide or its precursor obtd. by the reaction of a tetracarboxylic acid dianhydride or its deriv. and a diamine compd., (B) a photopolymerizable unsatd. compd. having at least one ethylene-type unsatd. group at the molecular end, (C) a compd. having a dihydrobenzoxazine ring, and (D) a photopolymn, initiator which produces free radicals by irradiation of actinic rays. A soln. of the photosensitive resin compsn. above described is applied on a substrate, dried, exposed according to an image and developed by using an alkali aq. soln. as a developer containing 0.1 to 50 wt.% surfactant or org. solvent and 0.01 to 30 wt.% inorg. alkali compd.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-282155

(43)公開日 平成11年(1999)10月15日

(51) Int.Cl. 8	戲別記号		FΙ			
G03F 7/02	7 514		G03F '	7/027	514	
C08F 2/44			C08F	2/44	С	
283/04			283	3/04		
C08L 51/08			C08L 5	51/08		
79/08			7:	9/08	В	
,		審査請求	未請求 請求項	質の数7 OL	(全 14 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平10-81841		(71) 出顧人	000004455		
(CY) MAN H	10077 ==			日立化成工業	株式会社	
(22)出願日	平成10年(1998) 3月27日			東京都新宿区	西新宿2丁目	1番1号
() [(72)発明者	川上 広幸		
	·			茨城県日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株式会	社茨城研究所	内
			(72)発明者	土川 信次		
				茨城県日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株式会	社茨城研究所	内
			(72)発明者	太田 文彦		
				茨城県日立市	東町四丁目13	番1号 日立化
				成工業株式会	社茨城研究所	内
			(74)代理人	弁理士 若林	邦彦	
						最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 感光性樹脂組成物及びこれを用いたソルダーレジストの製造法

(57)【要約】

【課題】 耐熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れる感光性樹脂組成物並びに作業性及び感光特性に優れるソルダーレジストを有する基板の製造法を提供する。

【解決手段】 (A) テトラカルボン酸二無水物又はその誘導体とジアミン化合物とを反応させて得られるポリイミド又はその前駆体、(B) 末端にエチレン性不飽和基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物、

- (C) ジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物及び
- (D)活性光の照射により遊離ラジカルを生成する光重合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物並びにこの感光性樹脂組成物の溶液を基板上に塗布し、乾燥後、像的に露光し、次いで界面活性剤又は有機溶剤を0.1~50重量%及び無機アルカリ性化合物を0.01~30重量%含有するアルカリ性水溶液を現像液に用いて、現像を行うことを特徴とするソルダーレジストを有する基板の製造法。

20

【特許請求の範囲】

(A) テトラカルボン酸二無水物又はそ 【請求項1】 の誘導体とジアミン化合物とを反応させて得られるポリ イミド又はその前駆体、(B)末端にエチレン性不飽和 基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物、

1

(C) ジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物及び

(D) 活性光の照射により遊離ラジカルを生成する光重 合開始剤を含有してなる感光性樹脂組成物。

(A)成分のポリイミド又はその前駆体 【請求項2】 を(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対し 10 て20~95重量部、(B)成分の光重合性不飽和化合 物を(A)成分及び(B)成分の総量100重量部に対 して5~80重量部、(C)成分のジヒドロベンゾオキ サジン環含有化合物を(A)成分及び(B)成分の総量 100重量部に対して0.05~40重量部、(D)成 分の光重合開始剤を(A)成分及び(B)成分の総量1 00重量部に対して0.01~20重量部含有する請求 項1記載の感光性樹脂組成物。

さらに、非含窒素系溶媒を含む請求項1 【請求項3】 又は2記載の感光性樹脂組成物。

【請求項4】 非含窒素系溶媒が、ラクトン類、脂環式 ケトン類又はエーテル類である請求項3記載の感光性樹 脂組成物。

(C) 成分のジヒドロベンゾオキサジン 【請求項5】 環含有化合物が、対応するフェノール性水酸基を有する 化合物。ホルムアルデヒド及び1級アミンを反応させて えられるものである請求項1、2、3又は4記載の感光 性樹脂組成物。

請求項1~5のいずれかに記載の感光性 【請求項6】 樹脂組成物の溶液を基板上に塗布し、乾燥後、像的に露 30 光し、次いで界面活性剤又は有機溶剤を0.1~50重 量%及び無機アルカリ性化合物を0.01~30重量% 含有するアルカリ性水溶液を現像液に用いて、現像を行 うととを特徴とするソルダーレジストを有する基板の製 造法。

【請求項7】 現像後に活性光を照射する工程と後加熱 する工程を含む請求項6記載のソルダーレジストを有す る基板の製造法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、感光性樹脂組成物 及びこれを用いたソルダーレジストを有する基板の製造 法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、軽量化、多機 能化、髙信頼化、低価格化に対応して、プリント配線板 では、部品穴を使わず導体パターンの表面で部品と基板 との電気的接続を行う部品搭載方法(この方法は表面実 装方式と呼ばれる) が急激に伸展している。 プリント配 線板の製造には、従来からはんだ付け位置の限定及び配 50

線の保護の目的で感光性ソルダーレジストが用いられて いるが、表面実装方式を用いるプリント配線板に使用さ れる感光性ソルダーレジストには、従来以上に耐熱性、 耐湿性及び密着性が要求されるところ、従来のエポキシ 樹脂を主成分とする感光性ソルダーレジストでは、耐熱 性、耐湿性及び密着性が不十分であり、プレッシャー・ クッカー・テスト (以下PCTと略す) を行うと、レジ ストにふくれや剥がれが生じてしまう問題がある。

【0003】一方、半導体分野では、耐熱性、耐湿性及 び密着性に優れる感光性ポリイミド樹脂が配線保護のた め使用されている。しかし、感光性ポリイミドは、像形 成時にはポリイミドの前駆体のポリアミド酸の形態で用 いること、また、溶媒として髙沸点の含窒素系極性溶媒 を用いることから、上記の優れた特性の硬化膜を得るに は、通常300℃以上の髙温乾燥及び硬化を必要とす る。そのため、基板等の耐熱性の点から、プリント配線 板には使用できないという問題があった。

【0004】そこで、ポリイミド前駆体に、特殊なモノ マーや非含窒素系極性溶媒を使用することによって、低 温硬化可能な感光性樹脂組成物が開発されている。しか し、この感光性樹脂組成物は、低温硬化性、耐熱性及び 密着性等に優れるもの、耐湿性がまだ不十分である。 [0005]

【発明が解決しようとする課題】請求項1記載の発明 は、耐熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れる 感光性樹脂組成物を提供するものである。請求項2記載 の発明は、請求項1記載の発明に加えて、より耐湿性 (耐PCT性) に優れる感光性樹脂組成物を提供するも のである。請求項3記載の発明は、低温硬化性、耐熱 性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れる感光性樹 脂組成物を提供するものである。請求項4記載の発明 は、請求項3記載の発明に加えて、より低温硬化性に優 れる感光性樹脂組成物を提供するものである。請求項5 記載の発明は、請求項4記載の発明に加えて、より耐湿 性 (耐PCT性) に優れる感光性樹脂組成物を提供する ものである。請求項6記載の発明は、作業性及び感光特 性に優れるソルダーレジストを有する基板の製造法を提 供するものである。請求項7記載の発明は、請求項6記 載の発明に加えて、耐熱性、密着性、耐湿性及び電気特 性等のソルダーレジストに必要な諸特性に優れるソルダ ーレジストを有する基板の製造法を提供するものであ る。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A)テトラ カルボン酸二無水物又はその誘導体とジアミン化合物と を反応させて得られるポリイミド又はその前駆体、

(B) 末端にエチレン性不飽和基を少なくとも1個有す る光重合性不飽和化合物、(C)ジヒドロベンゾオキサ ジン環含有化合物及び(D)活性光の照射により遊離う ジカルを生成する光重合開始剤を含有してなる感光性樹

脂組成物に関する。

【0007】また、本発明は、(A)成分のポリイミド 前駆体又はその誘導体を(A)成分及び(B)成分の総 **重100重量部に対して20~95重量部、(B)成分** の光重合性不飽和化合物を(A)成分及び(B)成分の 総重100重量部に対して5~80重量部、(C)成分 のジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物を(A)成分 及び(B)成分の総量100重量部に対して0.05~ 40 重量部、(D) 成分の光重合開始剤を(A) 成分及 び(B)成分の総量100重量部に対して0.01~2 10 0 重量部含有する上記感光性樹脂組成物に関する。

3

【0008】また、本発明は、これらの感光性樹脂組成 物において、(A)成分が、さらに非含窒素系溶媒を含 有する感光性樹脂組成物に関し、また、その非含窒素系 溶媒が、ラクトン類、脂環式ケトン類又はエーテル類で ある感光性樹脂組成物に関する。また、本発明は、これ らの感光性樹脂組成物において、ジヒドロベンゾオキサ ジン環含有化合物が、対応するフェノール性水酸基を有 する化合物、ホルムアルデヒド及び1級アミンを反応さ せてなる感光性樹脂組成物に関する。

【0009】また、本発明は、これらの感光性樹脂組成 物のうちのいずれかの溶液を基板上に塗布し、乾燥後、 像的に露光し、次いで界面活性剤又は有機溶剤を0.1 ~50重量%及び無機アルカリ性化合物を0.01~3 0重量%含有するアルカリ性水溶液を現像液に用いて、 現像を行うことを特徴とするソルダーレジストを有する 基板の製造法に関する。また、本発明は、この製造法に おいて、現像後に活性光を照射する工程と後加熱する工 程を含むソルダーレジストを有する基板の製造法に関す る。

[0010]

【発明の実施の形態】以下、本発明の感光性樹脂組成物 について詳細に説明する。本発明の感光性樹脂組成物に おいて、(A)成分であるポリイミド又はその前駆体の 原料となるテトラカルボン酸二無水物は、例えば、一般 式(1)

【化1】

(式中、R¹は炭素原子数が2~240、好ましくは4 ~60、特に好ましくは4~30の4価の有機基、さら に具体的には、テトラカルボン酸二無水物の残基を示 し、好ましくはベンゼン環等の芳香族基を含む基であ る) で表され、その誘導体としては、炭素数1~4のア ルキル基を有するモノアルキルエステル又はジアルキル エステルがある。

【0011】また、(A)成分であるポリイミド又はそ の前駆体の原料となるジアミン化合物としては、例え ば、一般式(II)

[{k2}

 (Π) $H_2N-R^2-NH_2$

(式中、R'は炭素原子数が2~240、好ましくは2 ~60、特に好ましくは2~30の2価の有機基、さら に具体的には、ジアミン化合物の残基を示し、好ましく はベンゼン環等の芳香族基を含む基である)で表され

【0012】前記テトラカルボン酸二無水物としては、 特に制限は無く、例えば、ピロメリット酸、3,31, 4.4'-ベンゾフェノンテトラカルボン酸、3.

3′, 4, 4′-ビフェニルテトラカルボン酸、2,

3′, 3, 4′-ピフェニルテトラカルボン酸、2. 20

3′, 4, 4′-ピフェニルテトラカルボン酸、3,

3', 4, 4'-ジフェニルエーテルテトラカルボン 酸、1,2,5,6-ナフタレンテトラカルボン酸、

2.3.6,7-ナフタレンテトラカルボン酸、1,

4, 5, 8-ナフタレンテトラカルボン酸、2, 3,

5, 6, - ピリジンテトラカルボン酸、3, 4, 9, 1 0-ベリレンテトラカルボン酸、3, 3', 4, 4'ジフェニルスルホンテトラカルボン酸、m-ターフェニ ル-3, 3', 4, 4'-テトラカルボン酸、p-ター

30 フェニル-3,3',4,4'-テトラカルボン酸、 1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビ ス (2, 3-又は3, 4-ジカルボキシフェニル) プロ パン、2、2-ビス(2、3-又は3、4-ジカルボキ シフェニル)プロパン、2、2-ビス〔4'-(2、3 -又は3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プ ロバン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー 2. 2-ビス〔4′-(2,3-又は3,4-ジカルボ キシフェノキシ) フェニル) プロパン、2,3,6,7 -アントラセンテトラカルボン酸、1,2,7,8-フ 40 ェナンスレンテトラカルボン酸、4,4'-ビス(2,

3-ジカルボキシフェノキシ) ジフェニルメタン等の芳 香族テトラカルボン酸の二無水物、下記一般式(III)

[化3]

(式中、R'及びR'は一価の炭化水素基を示し、それぞ れ同一でも異なっていてもよく、kは1以上の整数であ る)で表わされる芳香族テトラカルボン酸二無水物、シ 10 クロブテンテトラカルボン酸、ブタンテトラカルボン酸 等の脂肪族テトラクルボン酸の二無水物などが挙げら れ、これらは単独又は2種以上を組み合わせて使用され る。

【0013】前記ジアミン化合物としては、特に制限は なく、例えば、2.2-ピスー[4-(4-アミノフェ ノキシ) フェニル] プロパン、2, 2-ビス-[3-(4-アミノフェノキシ) フェニル] プロパン、ピス [4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]スルホン、 ビス [4-(3-アミノフェノキシ) フェニル] スルホ 20 ン)] ビスアニリン、4,4'-[1,3-フェニレン ン、2,2-ビスー[4-(4-アミノフェノキシ)フ ェニル] ヘキサフルオロプロバン、2, 2-ビス-[4 - (3-アミノフェノキシ)フェニル] ヘキサフルオロ プロパン、ピス [4-(4-アミノフェノキシ)] ピフ ェニル、ピス[4-(3-アミノフェノキシ)]ピフェ ニル、ビス [1 - (4 -アミノフェノキシ)] ピフェニ ル、ピス[1-(3-アミノフェノキシ)]ピフェニ ル、ビス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニル]メ タン、ビス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル] メタン、ピス[4-(4-アミノフェノキシ)フェニ ル] エーテル、ピス[4-(3-アミノフェノキシ)フ ェニル] エーテル、ピス [4-(4-アミノフェノキ シ)]ベンゾフェノン、ピス[4-(3-アミノフェノ キシ)]ベンゾフェノン、ピス[4-(4-アミノフェ ノキシ)]ベンズアニリド、ビス[4-(3-アミノフ ェノキシ)]ベンズアニリド、9、9-ビス[4-(4 -アミノフェノキシ)フェニル]フルオレン、9、9-ピス[4-(3-アミノフェノキシ)フェニル]フルオ レン、4,4′-(又は3,4′-、3,3′-、2, 4'-、2,2'-)ジアミノジフェニルエーテル、 4, 4'-(又は3, 4'-、-3, 3'-、2, 4' -、2,2'-)ジアミノジフェニルメタン、4,4' - (又は3、4' -、3、3' -、2、4' -、2、 2′-) ジアミノジフェニルスルホン、4,4′-(又 は3, 4′ -、3, 3′ -、2, 4′ -、2, 2′ -) ジアミノジフェニルスルフィド、p-フェニレンジアミ ン、m-フェニレンジアミン、p-キシリレンジアミ ン、mーキシリレンジアミン、o-トリジン、o-トリ ジンスルホン、4,4'ーメチレンービスー(2,6-ジエチルアニリン)、4,4'-メチレン-ピス-

(2,6-ジイソプロピルアニリン)、2,4-ジアミ ノメシチレン、1,5-ジアミノナフタレン、4,4' ーベンゾフェノンジアミン、1, 1, 1, 3, 3, 3 -ヘキサフルオロ-2, 2-ビス(4-アミノフェニル) プロパン、3,3'ージメチルー4,4'ージアミノジ フェニルメタン、3,3',5,5'-テトラメチルー 4, 4'-ジアミノジフェニルメタン、2, 2-ビス (4-アミノフェニル) プロパン、ベンジジン、2,6 -ジアミノビリジン、3, 3' -ジメトキシベンジジ ン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、 1, 3-ビス(4-アミノフェノキシ)ベンゼン、4, 4'-[1, 4-フェニレンピス(1-メチルエチリデ ピス(1-メチルエチリデン)] ピスアニリン、3,5 ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミン、エチレンジア ミン、テトラメチレンジアミン、ヘキサメチレンジアミ ン、1、2-ジアミノシクロヘキサン、下記一般式(I V)

【化4】

30

$$H_{2}N-R^{5}\begin{pmatrix} R^{7} \\ I \\ Si-O \end{pmatrix} + Si-R^{5}-NH_{2}$$
 (IV)

(式中、R'及びR'は炭素原子数1~30の二価の炭化 水素基を示し、それぞれ同一でも異なっていてもよく、 R'及びR'は一価の炭化水素基を示し、それぞれ同一で も異なっていてもよく、mは1以上の整数である)で表 わされるジアミノポリシロキサン、1,3-ビス(アミ ノメチル) シクロヘキサン、サン テクノケミカル(株) 製 ジェファーミン D-230、D-400、D-2 000, D-4000, ED-600, ED-900, ED-2001、EDR-148等のポリオキシアルキ 40 レンジアミン等の脂肪族ジアミン等が挙げられる。これ らは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用される。 【0014】本発明におけるポリイミド前駆体は、前記 テトラカルボン酸二無水物と前記ジアミン化合物を有機 溶媒中で反応させることにより得られるが、それらの使 用割合は、テトラカルボン酸二無水物/ジアミン化合物 が1.1/1.0~1.0/1.1(モル比)の範囲と することが好ましい。この範囲を超えると、ポリイミド 前駆体の分子量が成長しないため、耐熱性等が低下する 傾向がある。

50 【0015】本発明のポリイミド前駆体を生成する反応

に使用する溶媒としては、非含窒素系極性溶媒が好まし く、その具体例としては、アーブチロラクトン、アーバ レロラクトン、ャーカプロラクトン、ャーヘプタラクト ン、α-アセチル-γ-ブチロラクトン、ε-カプロラ クトン等のラクトン類、ジオキサン、1,2-ジメトキ シメタン、ジエチレングリコールジメチル(又はジエチ ル、ジブロピル、ジブチル) エーテル、トリエチレング リコールジメチル(又はジエチル、ジプロピル、ジブチ ル) エーテル、テトラエチレングリコール (又はジエチ ル、ジブロビル、ジブチル)エーテル等のエーテル類、 エチレンカーボネート、プロピレンカーボネート等のカ ーボネート類、メチルエチルケトン、メチルイソブチル ケトン、シクロヘキサノン、アセトフェノン等のケトン 類、ブタノール、オクチルアルコール、エチレングリコ ール、グリセリン、ジエチレングリコールジメチル(又 はモノメチル) エーテル、トリエチレングリコールジメ チル (又はモノメチル) エーテル、テトラエチレングリ コールジメチル (又はモノメチル) エーテル等のアルコ ール類、フェノール、クレゾール、キシレノール等のフ ェノール類、酢酸エチル、酢酸プチル、エチルセロソル 20 ブアセテート、ブチルセロソルブアセテート等のエステ ル類、トルエン、キシレン、ジエチルベンゼン、シクロ ヘキサン等の炭化水素類、トリクロロエタン、テトラク ロロエタン、モノクロロベンゼン等のハロゲン化炭化水 素類等を用いることができるが、高揮発性であって低温 硬化性を付与できるャープチロラクトンが最も好まし

[0016] 非含窒素系極性溶媒の使用量は、生成する ボリイミド前駆体の1~10倍(重量比)とすることが 好ましい。1倍未満では、合成時の粘度が高すぎて、撹 30 拌不能により合成が困難となる傾向があり、10倍を超 えると、反応速度が低下する傾向がある。

64

[0017] テトラカルボン酸二無水物とジアミン化合 物の反応は、80℃以下で行うことが好ましく、0~5 0℃で行うことが特に好ましい。これによりポリアミド 酸が生成する。また、このポリアミド酸は一部イミド化 していてもよく、これらを総称してポリイミド樹脂前駆 体という。従って、反応温度は250℃まで昇温しても よい。ポリイミド前駆体は液晶配向膜用組成物の溶剤に 可溶性であることが好ましい。この前駆体は、基板上に 40 液晶配向膜形成性樹脂の層を形成するとき、すなわち、 液晶配向膜用組成物を塗布し、加熱乾燥するときに、完 全にイミド化されポリイミド樹脂とされることが好まし い。また、前記ポリイミド樹脂前駆体は液晶配向膜用組 成物の溶剤に可溶であるならば、予め、イミド化してお くととができる。イミド化には、前記の反応を120~ 250℃で行う熱イミド化、脱水剤の存在下に反応させ る化学イミド化がある。脱水剤としては、無水酢酸、無 水プロビオン酸、無水安息香酸等の酸無水物、ジシクロ ヘキシルカルボジイミド等のカルボジイミド化合物等が 50

好ましく、テトラカルボン酸二無水物1モルに対して1 ~8 モル使用することが好ましい。また、このとき、脱 水触媒としてピリジン、イソキノリン、トリメチルアミ ン、アミノピリジン、イミダゾール等を必要に応じて使 用することができる。脱水触媒はテトラカルボン酸二無 水物1モルに対して1~8モル使用することが好まし

【0018】(B)成分であるエチレン性不飽和基を少 なくとも1個有する光重合性不飽和化合物としては特に 制限は無く、例えば、アクリル酸メチル、メタクリル酸 メチル、アクリル酸エチル、メタクリル酸エチル、アク リル酸ブチル、メタクリル酸プチル、アクリル酸2-エ チルヘキシル、メタクリル酸2-エチルヘキシル、ペン テニルアクリレート、ペンテニルメタクリレート、ベン ジルアクリレート、ベンジルメタクリレート、テトラヒ ドロフルフリルアクリレート、テトラヒドロフルフリル メタクリレート、ポリエチレングリコール (メタ) アク リレート (エチレン基の和が2~14のもの)、ポリプ ロピレングリコールジ (メタ) アクリレート (プロピレ ン基の和が2~14のもの)、トリメチロールプロパン ジアクリレート、トリメチロールプロパントリアクリレ ート、トリメチロールプロパンジメタクリレート、トリ メチロールプロパントリメタクリレート、トリメチロー ルプロパンエトキシトリアクリレート、トリメチロール プロバンエトキシトリメタクリレート、トリメチロール プロパンプロポキシトリアクリレート、トリメチロール プロパンプロポキシトリメタクリレート、テトラメチロ ールメタンテトラアクリレート、テトラメチロールメタ ンテトラメタクリレート、1,4-ブタンジオールジア クリレート、1、6-ヘキサンジオールジアクリレー ト、1,4-ブタンジオールジメタクリレート、1,6 - ヘキサンジオールジメタクリレート、ペンタエリスリ トールトリアクリレート、ペンタエリスリトールテトラ アクリレート、ペンタエリスリトールトリメタクリレー ト、ペンタエリスリトールテトラメタクリレート、ジベ ンタエリスリトールペンタアクリレート、ジペンタエリ スリトールペンタメタクリレート、ジペンタエリスリト ールヘキサアクリレート、ジペンタエリスリトールヘキ サメタクリレート、スチレン、ジピニルベンゼン、4-ピニルトルエン、4-ビニルピリジン、N-ビニルピロ リドン、2-ヒドロキシエチルアクリレート、2-ヒド ロキシエチルメタクリレート、1,3-アクリロイルオ キシ-2-ヒドロキシプロパン、1,2-メタクリロイ ルオキシー2-ヒドロキシプロパン、メチレンピスアク リルアミド、N、Nージメチルアクリルアミド、Nーメ チロールアクリルアミド、トリス (β-ヒドロキシエチ ル) イソシアヌレートのトリアクリレート、下記一般式 (V)

【化5】

9
$$CH_{2}$$

$$CH_{2}$$

$$C-R^{9}$$

$$C-R^{9}$$

$$C-C+CH_{2}CH_{2}O)_{q}$$

$$CH_{3}$$

$$CH_{4}$$

$$C-R^{9}$$

(式中、R*は水素又はメチル基を示し、q及びrは1 以上の整数である)で表わされる化合物、グリシジル基 含有化合物 κα, β-不飽和カルボン酸を付加して得ら れる化合物、例えば、トリメチロールプロパントリグリ シジルエーテルトリ (メタ) アクリレート、ピスフェノ 10 ールAジグリシジルエーテルジ(メタ)アクリレート 等、多価カルボン酸、例えば、無水フタル酸等と水酸基 及びエチレン性不飽和基を有する物資、例えば、β-ヒ ドロキシエチル(メタ)アクリレート等とのエステル化 物、トリレンジイソシアネートと2ーヒドロキシエチル (メタ) アクリル酸エステルとの反応物やトリメチルへ キサンジイソシアネートとシクロヘキサンジメタノール と2-ヒドロキシエチル (メタ) アクリル酸エステルと の反応物等のウレタン(メタ)アクリレート、ジアミン とイソシアネート化合物とエチレン性不飽和二重結合を 有するモノイソシアネート化合物との反応物等の、尿素 結合含有化合物等が挙げられる。 これらは単独で又は2 種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0019】ポリイミド前駆体とエチレン性不飽和基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物の使用量は、(A)成分であるポリイミド前駆体及び(B)成分であるエチレン性不飽和基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物の総量を100重量部として、ポリイミド前駆体95~20重量部及びエチレン性不飽和基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物5~80重 30量部が好ましい。ポリイミド前駆体が多すぎると光感度が劣る傾向があり、ポリイミド前駆体が少なすぎると硬化膜の耐熱性や機械特性が劣る傾向がある。

【0020】本発明の(C)成分であるジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物の合成は、フェノール性水酸基を有する化合物と1級アミンとの混合物を70℃以上に加熱したホルムアルデヒド中に添加して、70~110℃、好ましくは、90~100℃で20~120分反応させ、その後120℃以下の温度で減圧乾燥することにより合成することができる。フェノール性水酸基を有す40る化合物のフェノール性水酸基のすべてが第1級アミンとホルムアルデヒドと反応し、ジヒドロベンゾオキサジン環を形成するようにしたものが好ましい。

【0021】フェノール性水酸基を有する化合物として ロバン-1-オン、3,3´,4,4´ーテトラ(tーは、特に制限は無く、ピスフェノールA、ピスフェノー ブチルパーオキシカルボニル)ベンゾフェノン、3,3 dull が、3,3 dull が、3,3 dull が、3,3 dull が、4,4 dull が、4 dull が、4 dull が、5 dull が、6 dull が、7 dull が、6 dull が、6 dull が、7 dull が、7 dull が、6 dull が、7 dull が、

アルキルフェノールなどの1価のフェノール化合物、レゾルシノール、ビスフェノールA等の多価フェノール化合物などのフェノール化合物とホルムアルデヒドを反応させて得られるノボラック樹脂若しくはレゾール樹脂、フェノール変性キシレン樹脂、メラミンフェノール樹脂、ポリブタジエン変性フェノール樹脂等がある。1級アミンとしては、特に制限は無く、メチルアミン、シクロヘキシルアミン、アニリン、置換アニリン等を挙げるとかできる。ホルムアルデヒドは、ホルマリン、ボリバラホルムアルデヒドの形態で使用しても良い。

【0022】ジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物の使用量は、(A)成分であるボリイミド前駆体の固形分及び(B)成分であるエチレン性不飽和基を少なくとも1個有する光重合性不飽和化合物の総量を100重量部として、0.1~40重量部である。この使用量が0.1重量部未満だと耐湿性が劣る傾向があり、40重量部を超えると、感光性樹脂組成物の保存安定性が劣る傾向がある。また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて、光重合開始剤を含有することができる。

【0023】(D)成分である光重合開始剤としては、 特に制限はなく、例えば、ミヒラーズケトン、ベンゾイ ンメチルエーテル、ベンゾインエチルエーテル、ベンゾ インイソプロピルエーテル、2 - t - ブチルアントラキ ノン、2-エチルアントラキノン、4,4'-ピス(ジ エチルアミノ) ベンゾフェノン、アセトフェノン、ベン ゾフェノン、チオキサントン、2、4-ジエチルチオキ サントン、2、2-ジメトキシ-2-フェニルアセトフ ェノン、1-ヒドロキシシクロヘキシルフェニルケト ン、2-メチルー〔4-(メチルチオ)フェニル〕-2 ーモルフォリノー1ープロパノン、ベンジルジフェニル ジスルフィド、フェナンスレンキノン、2-イソプロピ ルチオキサントン、リボフラピンテトラブチレート、 2, 6-ビス(p-ジエチルアミノベンザル)-4-メ チル-4-アザシクロヘキサノン、N-エチル-N-(p-クロロフェニル) グリシン、N-フェニルジエタ ノールアミン、2-(o-エトキシカルボニル)オキシ イミノー1、3ージフェニルプロパンジオン、1ーフェ ニル-2- (o-エトキシカルボニル) オキシイミノブ ロパン-1-オン、3, 3', 4, 4'-テトラ(tー ブチルパーオキシカルボニル) ベンゾフェノン、3,3 カルボニルビス(7-ジエチルアミノクマリン)、ピ ス (シクロペンタジエニル) - ピスー〔2, 6 - ジフル オロー3ー(ピリー1ーイル)フェニル]チタニウム、 3, 3'ージメトキシー4, 4'ージアザドビフェニ

12

-1-メチル-4-アザシクロヘキサノン、4-メチル -7-ジエチルアミノクマリン、4、6-ジメチル-7 -エチルアミノクマリン、7-ジエチルアミノ-3-テ ノニルクマリン、ベンジルジメチルケタール、2-ベン ジル-2-ジメチルアミノ-1-(4-モルフォリノフ ェニル)ーブタン-1-オン、4-ジエチルアミノ安息 香酸エチル、1、3-ジフェニルプロパントリオン-2 -(0-エトキシカルボニル)オキシム、N-(4-シ アノフェニル)グリシン、1、7-ビス(9-アクリジ ニル)ヘブタン等が挙げられる。これらは単独又は2種 10 類以上を組み合わせて使用することもできる。*

* [0024] 光重合開始剤の使用量は、ポリイミド前駆体の樹脂分に対して、0.01~30重量%とすることが好ましく、0.05~10重量%とすることがより好ましい。この使用量が、0.01重量%未満では、光感度が劣る傾向があり、30重量%を超えると、フィルムの機械特性等が劣る傾向がある。
[0025] また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要にないて、アジドル合物を含有するととができる。

[0025] また、本発明の感光性樹脂組成物には、必要に応じて、アジド化合物を含有することができる。 [0026] アジド化合物として、例えば、 (化6]

$$N_{3}$$
 N_{3}
 N_{4}
 N_{5}
 N_{5}

【化7】

сн₂он

合わせて使用することもできる。

【0027】アジド化合物の使用量は、ポリイミド前駆 体の樹脂分に対して、0.01~30重量%とすること が好ましい。との使用量が、0.01重量%未満では、 光感度が劣る傾向があり、30重量%を超えると、フィ ルムの機械特性等が劣る傾向がある。

【0028】また、本発明の感光性樹脂組成物には、保 存時の安定性を髙めるために、ラジカル重合禁止剤又は ラジカル重合抑制剤を含有することもできる。ラジカル 重合禁止剤又はラジカル重合抑制剤としては、例えば、

等が挙げられる。これらは単独で又は2種類以上を組み 40 ヒドロキノン、ヒドロキノンモノメチルエーテル、ベン ゾキノン、ジフェニルーpーベンゾキノン、ピロガロー ル、フェノチアジン、カテコール、レゾルシノール、オ ルトジニトロベンゼン、パラジニトロベンゼン、メタジ ニトロベンゼン、フェナントラキノン、N-フェニルー 1-ナフチルアミン、N-フェニル-2-ナフチルアミ ン、クペロン、フェノチアジン、2,5-トルキノン、 タンニン酸、パラベンジルアミノフェノール、ニトロソ アミン類等が挙げられる。 これらは単独で又は2種類以 上を組み合わせて使用することができる。ラジカル重合 50 禁止剤又はラジカル重合抑制剤の使用量は、ポリイミド

前駆体の樹脂分に対して、0.01~30重量%とする ことが好ましい。この使用量が、0.01重量%未満で は、保存安定性が劣る傾向があり、30重量%を超える と、光感度及びフィルムの機械特性等が劣る傾向があ る。

【0029】本発明の感光性樹脂組成物は、その硬化性 を向上させるために、ブロックポリイソシアネート化合 物又はピスマレイミド化合物を添加することもできる。 【0030】ブロックポリイソシアネート化合物として は、トリレンジイソシアネート、ジフエニルメタンジイ 10 ソシアネート、ナフタレンジイソシアネート、キシリレ ンジィソシアネート、ジフエニルスルホンジイソシアネ ート、トリフエニルメタンジイソシアネート、ヘキサメ チレンジイソシアネート、3 - イソシアネートメチルー 3.5.5-トリメチルシクロヘキシルイソシアネー ト、3-イソシアネートエチル-3,5,5-トリメチ ルシクロヘキシルイソシアネート、3-イソシアネート エチル-3,5,5-トリエチルシクロヘキシルイソシ アネート、ジフエニルプロパンジイソシアネート、フエ ニレンジイソシアネート、シクロヘキシリレンジイソシ アネート、3, 3′ -ジイソシアネートジプロピルエー テル、トリフェニルメタントリイソシアネート、ジフエ ニルエーテル-4,4'-ジイソシアネート等のポリイ ソシアネートをフェノール、キシレノール等のフェノー ル類、オキシム類、イミド類、メルカプタン類、アルコ ール類、ε-カプロラクタム、エチレンイミン、α-ピ ロリドン、マロン酸ジエチル、亜硫酸水素ナトリウム、 ホウ酸などでブロック化したものなどが挙げられる。と れらは単独で又は2揮以上組み合わせて用いられる。市 販品としては、例えば、住友バイエルウレタン(株)製デ スモジュール BL3175、APステーブル、AP-12ステーブル、CTステーブル、BL1100、BL 1190、BL1265、AP-2170ステーブル、 BL4165、TPLS-2759、デスモカップ 1 1、12、クレラン UT、UI、U12、TPKL5 -2668、TPLS-2727、デスモサーム 21 70、2265、日立化成工業(株)製 WD 2502 等を使用することができる。これらは単独で又は2種類 以上を組み合わせて使用することができる。

【0031】ブロックポリイソシアネート化合物の添加 方法としては、添加するブロックポリイソシアネート化 合物を予め感光性樹脂組成物に含まれる溶媒と同一の溶 媒び溶解してから添加することができ、直接感光性樹脂 組成物に添加するとともできる。ブロックポリイソシア ネート化合物は、(A)成分及び(B)成分の合計量1 ○○重量部に対して、○・1~50重量部とすることが 好ましく、0.5~40重量部とすることが特に好まし い。ブロックポリイソシアネート化合物が少なすぎる と、硬化性の向上が不十分になり、多すぎると組成物の 粘度安定性が劣る傾向がある。

【0032】ビスマレイミド化合物としては、例えば、 4, 4'-(又は3, 4'-、-3, 3'-、2, 4' -、2,2′-)ジアミノジフェニルエーテル)、4, 4′-(又は3,4′-、-3,3′-、2,4′-、 (又は3, 4′-、-3, 3′-、2, 4′-、2, 2′-) ジアミノジフェニルスルホン、4,4′-(又 は3, 4′-、-3, 3′-、2, 4′-、2, 2′ -) ジアミノジフェニルスルフィド、パラフェニレンジ アミン、メタフェニレンジアミン、p-キシリレンジア ミン、mーキシリレンジアミン、oートリジン、oート リジンスルホン、4、4′ーメチレンーピスー(2、6 **-ジエチルアニリン)、4,4'-メチレン-ビスー** (2.6-ジイソプロピルアニリン)、2,4-ジアミ ノメシチレン、1,5-ジアミノナフタレン、4,4' −ベンゾフェノンジアミン、ピス〔4 − (4′ −アミノ フェノキシ) フェニル] スルホン、1, 1, 1, 3, 3, 3-ヘキサフルオロー2, 2-ビス(4-アミノフ ェニル) プロパン、2,2-ビス〔4-(4'-アミノ フェノキシ)フェニル]プロパン、3,3'ージメチル -4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,3', 5, 5'-テトラメチルー4, 4'ージアミノジフェニ ルメタン、ピス〔4-(3'-アミノフェノキシ)フェ ニル] スルホン、2、2-ビス(4-アミノフェニル) プロパン、3,5-ジアミノ安息香酸等の芳香族ジアミ ンのピスマレイミド化物を使用することができる。これ らは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用すること ができる。

【0033】ピスマレイミド化合物の添加方法として は、添加するビスマレイミド化合物を予め感光性樹脂組 成物に含まれる溶媒と同一の溶媒び溶解してから添加す ることができ、直接感光性樹脂組成物に添加することも できる。ピスマレイミド化合物は、(A)成分及び (B) 成分の合計量100重量部に対して、0.1~5 ○重量部とするととが好ましく、○.5~40重量部と することが特に好ましい。ビスマレイミド化合物が少な すぎると、硬化性の向上が不十分になりやすく、多すぎ ると組成物の粘度安定性が劣る傾向がある。

【0034】ピスマレイミド化合物を添加する際は、そ の硬化性を向上させるために重合開始剤として有機過酸 化物を添加することもできる。有機過酸化物としては、 例えば、1, 1-ビス(t-ブチルパーオキシ)-3, 3, 5-トリメチルイシクロヘキサン、1, 1-ビス (t-ブチルパーオキシ) シクロヘキサン、t-ブチル パーオキシー3,3,5-トリメチルヘキサノエート、 t - ブチルパーオキシイソプロピルカーボネート、2, **5-ジメチル-2,5-ジ(ベンゾイルパーオキシ)へ** キサン、tープチルパーオキシベンゾエート、ジクミル パーオキサイド、2, 5-ジメチルー2, 5-ジ(tー 50 ブチルパーオキシ) ヘキサン、t - ブチルパーオキシ

17

(2-エチルヘキサノエート)、ジー t - ブチルハイドロパーオキサイド、t - ブチルパーオクトエート、ベンゾイルパーオキサイド等を用いることができる。これらは単独で又は2種類以上を組み合わせて使用することができる。有機化酸化物は、ビスマレイミド化合物100重量部に対して、0.001~10重量部とすることが好ましい。有機化酸化物が少なすぎると、硬化性の向上が不十分になりやすく、多すぎると組成物の粘度安定性が劣る傾向がある。

【0035】本発明の感光性樹脂組成物は、塗布法、浸 10 漬法、スプレー法、スクリーン印刷法、回転塗布法によってシリコンウェハー、金属基板、セラミック基板、銅 張積層板等の基板上に塗布され、溶剤の大部分を加熱乾燥することによって粘着性のない塗膜とすることができる。この塗膜上に、所望のパターンが描かれたマスクを通して活性光線又は化学線を照射後、未照射部を適当な現像液で溶解除去することによって、ソルダーレジストを製造することができる。

【0036】本発明の感光性樹脂組成物に照射する活性 光線又は化学線としては、例えば、超高圧水銀灯を用い 20 るコンタクト/プロキシミテイ露光機、ミラープロジェ クション露光機、i -線ステッパ、g -線ステッパ、そ の他の紫外線、可視光線、X線、電子線等を使用するこ とができる。

【0037】現像液に用いられる界面活性剤又は有機溶剤は、水と良く混合して均一な現像液となるものでも良く、また、水とほとんど混合せず不均一な現像液となるものでも良い。このような界面活性剤又は有機溶剤としては、例えば、ブチルカルビトール、N、Nージメチルアセトアミド、N、Nージメチルホルムアミド、メチルセコソルブ、エチルセロソルブ、3ーメチルー3ーメトキシブチルアセテート、ヘブタン酸ジエタノールアミド、ポリオキシエチレンーpークミルフェニルエーテル等を用いることができ、特にポリオキシエチレンーpークミルフェニルエーテルが好ましい。界面活性剤又は有機溶剤は、現像液中に0.1~50重量%含有されることが好ましい。

【0038】また、現像液に用いるアルカリ成分としては、炭酸ナトリウム、水酸化ナトリウム、四ホウ酸ナトリウム等が、0.01~30重量%の範囲で用いること 40ができる。

【0039】また、現像に用いる際の現像液の温度は、 感光層の現像性によって調節される。また、との現像液 中には、他の界面活性剤、消泡剤等を混入させても良 い。

【0040】現像後は、必要に応じて、水又は貧溶媒で あった。なお、重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトクリンスを行ない、室温以上で100℃前後以下の温度で ラフィー法(GPC、装置は(株)日立製作所製)を用いた。 ない、パターンを安定なものとすることが好ましい。 て、標準ポリスチレン換算により求めた。また、得られて、現像後、耐湿熱性、はんだ耐熱性、耐薬品性等を たポリイミド前駆体を乾燥させたものを、KBF法によの上させる目的で、高圧水銀灯による紫外線照射や、加 50 り、赤外吸収スペクトル(日本電子(株)製、JIR-1

熱を行なうこともできる。紫外線照射時の紫外線照射量 は、0. 2~10J/cm²とすることが好ましく、照射の 際の温度は、60~150℃とすることが好ましい。加 熱温度は、150~250℃とすることが好ましく、加 熱時間は、15~120分とすることが好ましい。これ ら紫外線照射と加熱は、どちらが先でも良いが、紫外線 照射を先に、加熱をその後に行うことがより好ましい。 【0041】また、とのレリーフパターンを、加熱する ことによってパターン化された高耐熱性ポリイミドを形 成することができる。この時の加熱温度は、80~45 0℃とすることが好ましく、80℃~250℃とするこ とがより好ましい。この加熱温度が、80℃未満及び4 50℃を超えると、ポリイミド膜の機械特性及び熱特性 が低下する傾向がある。また、との時の加熱時間は、 0.05~10時間とすることが好ましい。この加熱時 間が、0.05時間未満及び10時間を超えると、ポリ イミド膜の機械特性及び熱特性が低下する傾向がある。 このようにして本発明の感光性樹脂組成物は、各種保護 膜、絶縁膜等に使用することができる。

0 [0042]

【作用】本発明おける感光性樹脂組成物には、ジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物が含有されるので、また、従って、その光硬化物にもジヒドロベンゾオキサジン環含有化合物が含まれる。その化合物は加熱されると、ジヒドロベンゾオキサジン環が解裂し、水酸基とアミノ基が生成して、ヒンダードフェノール化合物になり、酸化防止剤として機能する。これにより、上記の光硬化物が金属銅(例えば、回路板の配線部等の銅)に接触する場合、加熱等により溶け出す銅イオンの酸化が防止され、光硬化物と銅の界面での酸化銅の生成が抑制され、密着性が保たれる。

[0043]

【実施例】以下、本発明を実施例により詳細に説明す る。

合成例1 (ポリイミド前駆体溶液の合成)

撹拌機、温度計、窒素導入管及び冷却水を備えた100mlフラスコに、(B)成分としての2,2′ービス(4ー(4ーアミノフェノキシ)フェニル)プロパン8.2 11g(0.02モル)及びケーブチロラクトン44.739gを仕込んだ後、4,4′ーベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物6.702g(0.0208モル)を少量ずつ添加した。添加後、45℃で約5時間反応を続けた後、室温に冷却して、不揮発分25重量%のポリイミド前駆体溶液(PI-1)を得た.得られたポリイミド前駆体溶液の重量平均分子量は84,000であった。なお、重量平均分子量は、ゲル浸透クロマトグラフィー法(GPC、装置は(株)日立製作所製)を用いて、標準ポリスチレン換算により求めた。また、得られたポリイミド前駆体を乾燥させたものを、KBr法により、赤外吸収スペクトル(日本電子(株)製、JIR-1

00型)を測定したところ、いずれも、1600㎝1付 近にアミド基のC=O吸収と、3300㎝ 1付近にN-Hの吸収が確認された。

【0044】合成例2(光重合性不飽和化合物の合成) 撹拌機、温度計、窒素導入管、滴下ロート及び冷却管を 備えた1リットルフラスコに、トリメチルヘキサメチレ ンジイソシアネート210g (1.00モル) 及びトル エン137.3gを仕込んだ後、70℃に昇温し、70 ~75℃保ちながら、シクロヘキサンジメタノール72 g (0.50モル)及び2-ヒドロキシエチルメタクリ 10 有化合物の合成) レート130g(1.00モル)を少量ずつ滴下した。 滴下後、70℃で約5時間反応を続けた後、室温に冷却 して光重合性不飽和化合物(M-1)を得た。

【0045】合成例3(ジヒドロベンゾオキサジン環含 有化合物の合成)

〈フェノールノボラック樹脂の合成〉フェノール190 g、ホルマリン(37%水溶液)100g及びしゅう酸

0.4gを5リットルフラスコに仕込み、還流温度で 約6時間反応させた。引続き、内部を6.66×10°P a以下に滅圧してから未反応のフェノール及び縮合水を 除去した。得られた樹脂は、軟化点84℃(環球法)、 3~多核体/2核体比:82/18(GPCによるピー ク面積比)であった。

【0046】(ジヒドロベンゾオキサジン環の導入)上 記により合成したフェノールノボラック樹脂170g (水酸基1.6モル相当)をアニリン140g(1.6 モル) と混合し、80°Cで5時間撹拌して均一な混合溶 液を調製した。別に、500mlフラスコ中に、ホルマリ ン259gを仕込み、90℃まで加熱した後、ここへ前 記で調製したフェノールノボラックとアニリンの混合溶 30 液を30分間かけて少しずつ添加した。添加終了後、3米

* 0分間還流温度に保ち、然る後に100℃で2時間6. 66×10³Pa以下に減圧して縮合水を除去し、反応し 得る水酸基の全てにジヒドロベンゾオキサジン環が導入 された化合物(R-1)を合成した。過剰のアニリンや ホルマリンは乾燥中に除かれ、この化合物の終了は、3 34gであった。とれは、フェノールノボラック樹脂の 水酸基のうち1. 4モルが反応し、ジヒドロベンゾオキ サジン環化したことを示している。

【0047】合成例4(ジヒドロベンゾオキサジン環含

撹拌機、温度計、窒素導入管、滴下ロート及び冷却管を 備えた1リットルフラスコ化、ピスフェノールF 20 0g、メチルエチルケトン230gを仕込み、溶解後、 ホルマリン143gを加えて撹拌した。次いで、溶液を 60℃に加熱し、アニリン82gを45分間かけて少量 づつ滴下した。滴下終了後、7時間還流下反応を続け た。この後、100℃で1時間6.66×10°Pa以下 の減圧度で濃縮を行い、所望のジヒドロベンゾオキサジ ン環が導入された化合物(R-2)300gを得た。 【0048】実施例1~7、比較例1

撹拌機、冷却管及び温度計を備えたフラスコに、合成例 1~4で得られたポリイミド前駆体溶液(PI-1)、 光重合性不飽和化合物 (M-1)、ジヒドロベンゾオキ サジン環含有化合物(R-1、R-2)、光開始剤であ るベンジルジメチルケタール(チバガイギー社製 【-651) 及びピクトリアピュアブルー(染料)を表1に 示す重量比で配合し、撹拌混合した後、フィルター濾過 し、均一な感光性樹脂組成物溶液(PPI-1~PPI - 7)を得た。

[0049]

【表1】

袋 1 合 単位: 選量部.

		実施例 1	実施例2	奥施例3		夹施例5	実施例 6	比較例1
		PP I - 1	P P I - 2	PP I - 3	PP I - 4	PPI-5	P P̀ I — 6	PP I - 4
ポリイミド前駆体溶液	P I - 1	40	40	4 0	40	4 0	40	4 0
光重合性不飽和化合物	M-1	.6 0	6 0	6 0	6 O	6 0	6 0	60
ジヒドロペンゾオキ	R - 1	1	5	10		-	-	_
サジン環合有化合物	R – 2	· –	_	-	1	5	1 0	
光開始割	I - 6 5 1	6	6	6	6	6	6	6
與 料	VPB .	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04

【0050】銅箔18μmの銅張積層板(日立化成工業 (株)製、MCL E-679)を、住友スリーエム社製 スコッチブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分 管乾燥した。との試験基板に、アプリケータを用いて上 記感光性樹脂組成物溶液(PPI-1~PPI-4)を 均一に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、9 50 た。評価結果を表2及び表3に示す。

O ℃で480秒間加熱し、約20 μmの塗膜を形成し *tc.*

【0051】とのようにして得られた感光性樹脂組成物 の層を形成した試験基板について、現像性、保存安定 性、はんだ耐熱性及び耐PCT性を以下の方法で評価し

(1)現像性

上記で得られた感光性樹脂組成物の層を形成した試験基板を、ヘプタン酸ジェタノールアミド 5重量%、炭酸ナトリウム 0.5重量%を含有するアルカリ水溶液を用いて、45℃で60秒間スプレー現像した。現像性は、30倍に拡大して残存する樹脂を目視で評価した。評価の基準は以下の通りである。

○:現像性の良好なもの(基板表面上に樹脂が全く残らないもの)

×:現像性の不良なもの(基板表面上に樹脂が少し残る 10 クラックや浮き、ハガレの発生が全く無いもの) もの) ×:はんだ耐熱性が不良なもの(感光性樹脂組成

(2)保存安定性

上記で得られた感光性樹脂組成物を室温(23℃)で1週間保存した後、(1)と同じ方法で試験基板を作製し、現像性を評価した。評価の基準は以下の通りである。

○:保存安定性の良好なもの(基板表面上に樹脂が全く 残らないもの)

×:保存安定性の不良なもの(基板表面上に樹脂が少し でも残るもの)

【0052】(3)はんだ耐熱性

前述の銅厚18μmの銅張積層板(日立化成工業(株)製、MCL E-679)を、住友スリーエム社製スコッチブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分間乾燥した。との試験基板に、アプリケーターを用いて上記感光性樹脂組成物(PPI-1~PPI-4)を均一に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、90℃で480秒間加熱し、約20μmの塗膜を形成した。次に、ネガマスクを感光性樹脂組成物の層の上から密着せ、オーク製作所製、HMW-680型露光機を使用し、500mJ/cmの露光量で露光した。次いで、ネガマスクを剥離した後、現像液にポリオキシエチレンーpークミルフェニルエーテル 2重量%、炭酸ナトリウム0.5重量%を含有するアルカリ水溶液を用いて、45℃で60秒間スプレー現像した。現像後、80℃で10分間加熱乾燥し、東芝電材社製紫外線照射装置を用いて

3 J/cm の量で紫外線を再照射し、その後、さらに乾燥機中200℃で60分間加熱した(空気雰囲気中)。 このようにして得られた試験基板表面に、ロジン系フラックスA-226 (タムラ化研社製)を塗布し、260℃のはんだ浴に180秒間浸漬し、その後、25℃のトリクレンに20秒間浸漬してフラックスを除去した。この

22

○:はんだ耐熱性が良好なもの(感光性樹脂組成物層に クラックや浮き ハガレの発生が全く無いもの)

ような操作を行った後、感光性樹脂組成物層の外観を評

×:はんだ耐熱性が不良なもの(感光性樹脂組成物層に クラックや浮き、ハガレの発生するもの)

【0053】(4)耐PCT性

価した。評価基準は次のとおりである。

前述の銅厚18μmの銅張積層板(日立化成工業(株) 製、MCL E-679)を住友スリーエム社製スコッ チブライトで研磨した後水洗し、80℃で15分間乾燥 した。この試験基板に、アプリケーターを用いて上記感 光性樹脂組成物溶液 (PPI-1~PPI-9)を均一 に塗布した。次いで、ホットプレートを用いて、90℃ 20 で480秒間加熱し、約20μmの塗膜を形成した。次 に、オーク製作所製、HMW-680型露光機を使用 し、500mJ/cm²の露光量で露光した後、東芝電材社製 紫外線照射装置を用いて3 J/cm²の量で再照射した。そ の後、さらに乾燥機中所定温度で60分間加熱した(空 気雰囲気中)。とのようにして得られた試験基板を、平 山製作所製PCT試験装置を用いて、121℃, 2.0 13×10'Paの条件で300時間までPCT処理を行 い、以下に示す方法で耐PCT性を評価した。耐PCT 性は、所定時間PCT処理した後の密着性を碁盤目試験 30 で評価した。なお、碁盤目試験は、カッタナイフで1 mm で100個のます目ができるように碁盤目状に傷をつ け、これをJIS規格(JIS K5400)に準じて セロテープで剥離し、100個のます目に対して、残存 したます目の個数で表す方法である。

[0054]

【表2】

									突施例 1								実施例 2								実施例3								- 実施例4									
R	8	光	性	樹	蹈	Æ	成	钩		PPI-1								P P I - 2							P P I - 3								P P I - 4									
Ħ	Į		傑		佳			•				,	2				0								0								0							7		
Ø	R	₹	7	安	叐	2	性			. 0							0								0								0							7		
k	t	k	,	E	耐	尭	5 E	Ė				(2								0					0								0								
Ð	Ę	-{	t	搵	E	ât.	(*	;)	1	6	0	1	8 C	2	0	0	1	6	0	1	8	0	2	0	0	1	6 (1	. 8	0	2	0	0	1	6 (2	1	В О	2	0	0	
								C	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0 0	1	. 0	0	1	0	0	1	0 (2	1	0 0	1	0	0
							2 4	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0 (1	0	0	1	0	0	1	0 (2	1 (0 0	1	0	0	
				•		1	0 0	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0 (1	0	0	1	0	0	1	0 (2	1 (0 0	1	0	0	
	ŧ	P	C	T	性	2	0 0	h	1	0	0	1	0 Q	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0 (1	. 0	0	1	0	0	1	0 (2	1 (0 0	1	0	0	
			3	0 0	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	i	0	o	1	0	0	ı	0	0	1	0 () 1	. 0	0	1	0	0	1	0 (2	1	0 0	1	0	0				
				4	0 0	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	.1	o c	1	. 0	0	ı	0	0	1	0 (Þ	1	0 0	1	0	이			
L						5	0 0	h	1	0	0	1	0 0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0 () 1	. 0	0	1	0	0	1	0 (o	1	0 0	1	0	٥	

[0055]

*【表3】

					_		T	奥施例 5										実施例 6									比較例 1										
133	光性	樹	脂	趄	成	物		. PPI-5 ·									P P I - 6									P P I - 4											
現		ó									. 0								0																		
保存安定性											0					0							0														
は		0									0							×																			
砚	化	搵	B	E	(C)	1	6	0	1	8	0	2	0	0	1	6	0	1	8	0	2	0	0	1	6	0	ı	8	0	2	0	0				
						0 h	ı	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	ı	0	0				
					2	4 h	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	.0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0				
			•	1	0	0 h	1	0	0	1	0	0	ı	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		0		1	0	0	1	0	0				
耐	P C	T	性	2	0	0 h	1	0	Ò	1	0	0	ı	0	0	1	0	0	1	0	0	ì	0	0		_			0			0					
				3	0	0 'h	1	0	0	1	.0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		_	-		_			_					
				4	0	0 h	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		· <u>-</u>			-			_					
1.				5	0	0 h	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0		_	Ì		_			_					

[0056]

[発明の効果]請求項1記載の感光性樹脂組成物は、耐 熱性、密着性及び耐湿性(耐PCT性)に優れ、各種保 護膜、絶縁膜等、特にソルダーレジストに好適である。 請求項2記載の感光性樹脂組成物は、請求項1記載の効 果を奏し、さらに耐湿性に優れる。請求項3記載の感光

性(耐PCT性)に優れる。請求項4記載の感光性樹脂 組成物は、請求項3記載の効果を奏し、さらに低温硬化 性に優れる。請求項5記載の感光性樹脂組成物は、請求 項3記載の効果を奏し、さらに耐湿性(耐PCT性)に 優れる。請求項6記載のソルダーレジストの製造法は、 作業性及び感光特性に優れる。 請求項7記載のソルダー 性樹脂組成物は、低温硬化性、耐熱性、密着性及び耐湿 50 レジストの製造法は、請求項6記載の効果を奏し、さら

に、耐熱性、密着性、耐湿性(耐 P C T 性)及び電気特* * 性等のソルダーレジストに必要な語特性に優れる。

フロントページの続き

(51)Int.C1.6 識別記号 F I
G O 3 F 7/004 5 O 1 G O 3 F 7/004 5 O 1
7/30 7/30
H O 5 K 3/28 H O 5 K 3/28 D

(72)発明者 西澤 ▲廣▼

茨城県日立市東町四丁目13番1号 日立化 成工業株式会社茨城研究所内 (72)発明者 相沢 輝樹

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館工場内

(72)発明者 沼田 俊一

茨城県下館市大字小川1500番地 日立化成

工業株式会社下館工場内